

**D2F60**  
**600V 1.4A**

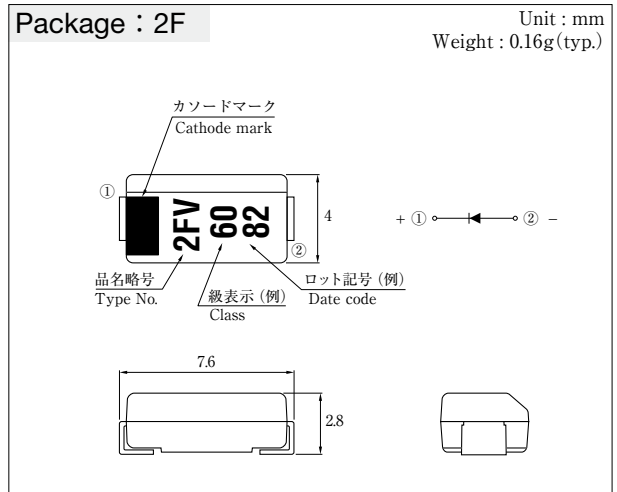
**特長**

- 小型 SMD
- 耐湿性に優れ高信頼性

**Feature**

- Small SMD
- High-Reliability

**■外観図 OUTLINE**



外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。  
For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

**■定格表 RATINGS**

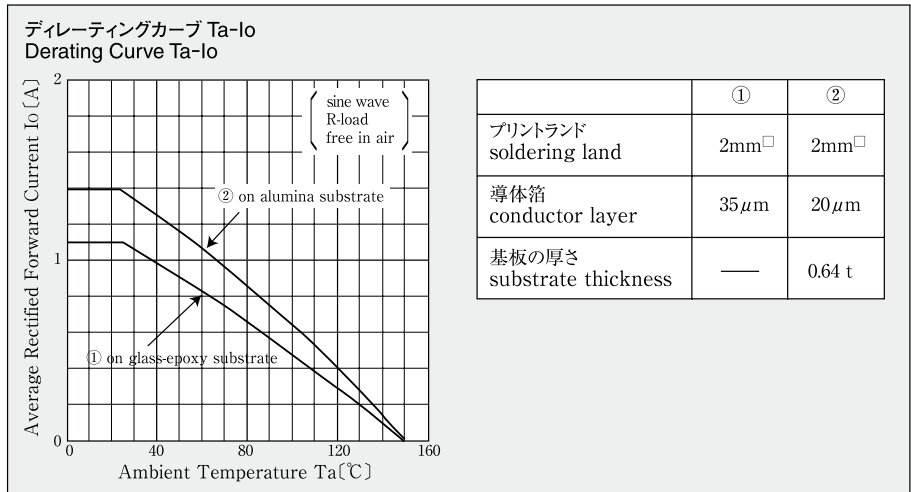
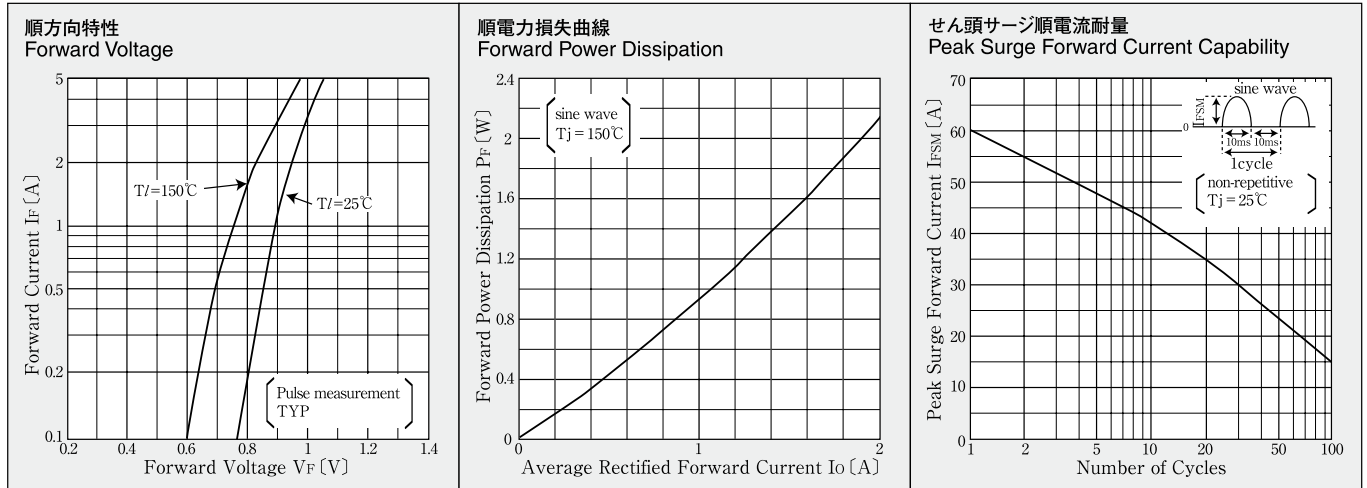
**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings** (指定のない場合  $T_l=25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D2F60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V <sub>RM</sub>			600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I <sub>O</sub>	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, Ta=25°C 50Hz sine wave, Resistance load, Ta=25°C	アルミナ基板実装 On alumina substrate	1.4	A
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	1.1	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, Tj=25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj=25°C		60	A

**●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics** (指定のない場合  $T_l=25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> = 1.4A, パルス測定 Pulse measurement		MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> = V <sub>RM</sub> , パルス測定 Pulse measurement		MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ <sub>j/l</sub>	接合部・リード間 Junction to Lead		MAX 24	°C/W
	θ <sub>ja</sub>	接合部・周囲間 Junction to Ambient	アルミナ基板実装 On alumina substrate プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	MAX 90 MAX 120	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



\* Sine wave は 50Hz で測定しています。  
 \* 50Hz sine wave is used for measurements.  
 \* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。  
 Typical は統計的な実力を表しています。  
 \* Semiconductor products generally have characteristic variation.  
 Typical is a statistical average of the device's ability.